

超低待机功耗多模式准谐振原边反馈交直流转换器

概述

PN8395集成超低待机功耗准谐振原边控制器及650V高雪崩能力智能功率MOSFET,用于高性能、外围元器件精简的充电器、适配器和内置电源。PN8395为原边反馈工作模式,可省略光耦和TL431,支持CCM和DCM两种工作模式。内置高压启动电路,可实现系统空载待机损耗(230VAC)小于50mW。在恒压模式,采用准谐振、多模式技术与PWM频率切换技术共同提高效率并消除音频噪声,使得系统满足6级能效标准,而频率抖动技术可实现较好的EMI特性;在恒流模式,输出电流和功率可通过CS脚的电阻进行调节。该芯片提供了极为全面的智能保护功能,包含逐周期过流保护、过压保护、开环保护、过温保护、输出短路保护和CS开/短路保护等。

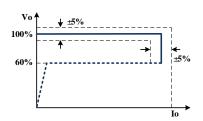
产品特征

- 内置650V高雪崩能力智能功率MOSFET
- 内置高压启动电路,小于50mW待机损耗(230VAC)
- 支持CCM和DCM两种工作模式
- 采用准谐振与多模式技术提高效率,满足6级能效标准
- 全电压输入范围±5%的CC/CV精度
- 原边反馈可省光耦和TL431
- 恒压、恒流、输出线补偿外部可调
- 无需额外补偿电容、无音频噪声
- 智能保护功能
 - ◆ 过温保护 (OTP)
 - ◆ VDD欠压&过压保护 (UVLO&OVP)
 - ◆ 逐周期过流保护 (OCP)
 - ◆ CS开/短路保护 (CS O/SP)
 - ◆ 开环保护 (OLP)

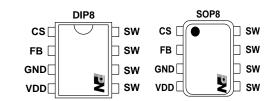
应用领域

- 开关电源适配器
- 机顶盒等外置电源

输出特性



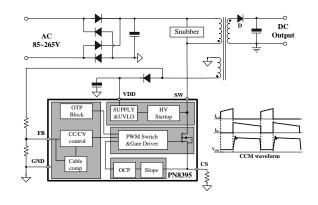
封装/订购信息



订购代码	封装	典型功率		
71 797 71号	1 1 次	90~265V _{AC}		
PN8395NEC-T1H	DIP8	24W		
PN8395NEC-T1M	DIP8	18W		
PN8395SEC-R1H	SOP8	18W		

注: 典型输出功率是在环境温度 40℃的密闭式应用 情形下测试。

典型应用





管脚定义

管脚名	管脚标号	管脚功能描述	
CS	1	电流检测引脚	
FB	2	反馈引脚,辅助绕组电压通过电阻反馈稳定输出	
GND	3	地电位	
VDD	4	工作电压输入引脚	
SW	5,6,7,8	智能功率MOSFET Drain端引脚,跟变压器初级相连	

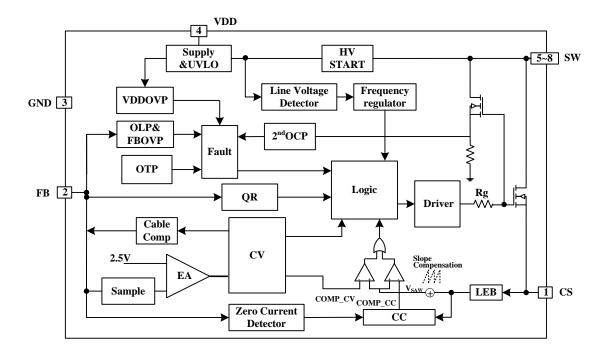
典型功率

产品型号	封装	密闭式条件(1)
) 加坐与		90~265V _{AC}
PN8395H	DIP8	24W
F10395H	SOP8	18W
PN8395M	DIP8	18W

备注:

1. 典型输出功率是在环境温度 40℃的密闭式应用情形下测试,输出电压为 12V。

功能框图



PN8395



极限工作范围

VDD 脚耐压0.3~40V	管脚焊接温度 (10秒)260℃
FB,CS 脚耐压0.3~5.5V	封装热阻 Rθ _{JC} (DIP8)40℃/W
SW 脚耐压0.3~650V	封装热阻 Rθ _{JC} (SOP8)80℃/W
结工作温度范围40~150℃	人体模式 ESD 能力 ⁽¹⁾ (HBM) ±4kV
存储温度范围55~150℃	漏极脉冲电流(T _{pulse} =100us)5A

备注: 1. 产品委托第三方严格按照芯片级ESD标准(JEDEC JS-001-2014)中的测试方式和流程进行测试。

电气特性

 $(T_A = 25$ ℃, $V_{DD} = 21$ V, 除非另有说明)

参数	符号	条件	最小值	典型值	最大值	单位
功率部分	•		•		•	
功率管耐压	BVDSS	$I_{SW} = 250 \text{uA}, T_J = 25 ^{\circ}\text{C}$	650	690		V
功率管导通电阻-PN8395H	R _{DS(on)}	$I_{SW} = 1A$, $T_J = 25$ °C		1.6		Ω
功率管导通电阻-PN8395M	R _{DS(on)}	$I_{SW} = 1A$, $T_J = 25$ °C		2.0		Ω
关态漏电流	I_{OFF}	V _{sw} =500V	10	20	50	uA
启动电压	V _{SW_START}	V _{DD} =V _{DDon} - 1V		22	25	V
VDD电压部分						
工作电压范围	V_{DD}		10		30	V
VDD启动阈值电压	V_{DDon}		14.5	17.0	18.0	V
VDD欠压保护阈值电压	V_{DDoff}		7.5	8.8	9.5	V
VDD过压保护电压	V_{DDovp}		30	32	35	V
VDD电流部分						
启动管对VDD充电电流	I_{DD_CH}	V _{DD} =V _{DDon} - 1V, Vsw=100V	-2.0	-1.0	-0.35	mA
开关工作时芯片电流	I_{DD}	$V_{DD} = V_{DDon} + 1V$	0.6	1.0	1.5	mA
保护状态时芯片电流	I _{DD_FAULT}	V _{DD} =15V after fault		1		mA
CS电流检测部分						
最大过流检测阈值电压	V _{TH_OC_MAX}		720	750	780	mV
最小CS检测阈值电压	V _{cs_min}			150		mV
斜坡补偿	V_{slope}			40		mV/us
恒流环路计算参数	K _{CC}			13.6		V/V
前沿消隐时间	T_{LEB}			300		ns
过流延时时间	T_{D_OC}			100		ns
FB电压检测部分						
恒压模式反馈基准电压	V _{REF_CV}		2.475	2.5	2.525	V
恒流模式基准电压	V _{REF_CC}		2.57	2.6	2.63	V
输出过压保护阈值电压	V _{FBOVP}		2.85	3	3.25	V
输出欠压保护阈值电压	V_{UVP}		1.45	1.55	1.65	V
最大线电阻补偿电流	Icable	V _{FB} =0V	54	59	64	uA

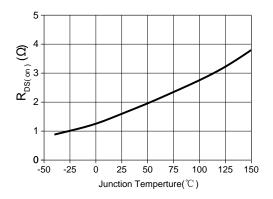
PN8395



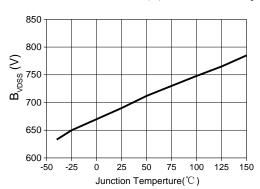
参数	符号	条件	最小值	典型值	最大值	单位
振荡器部分						
恒压CCM模式开关频率	F_{CCM}		52	58	64	kHz
最大占空比	D_{max}			67		%
最小关断时间	T_{offmin}			11		us
最大关断时间	T_{offmax}			2.2		ms
输出欠压保护屏蔽时间	T_{UVP}	开关频率50kHz	40		62	ms
过温保护部分						
过温保护温度	T_{SD}		135	150		$\mathcal C$
过温保护回差	T _{HYST}			30		$\mathcal C$

Chipown

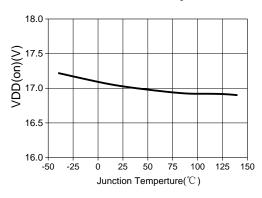
特性曲线



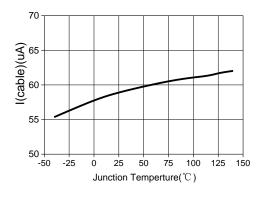




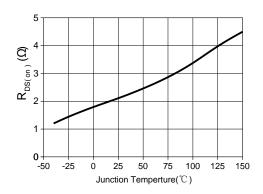
(c) B_{VDSS} vs T_j



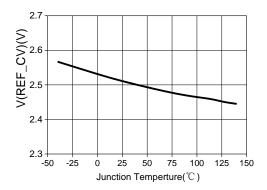
(e) V_{DDon} vs T_j



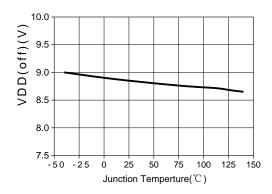
(g) Icable vs T_j



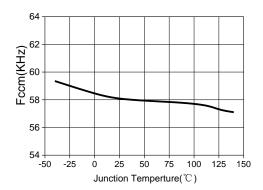
(b) $R_{DS(on)}$ -PN8395M vs T_j



(d) V_{REF_CV} vs T_j



(f) V_{DDoff} vs T_j



(h) F_{CCM} vs T_j

5 / 12

Chipown

功能描述

高性能的原边反馈控制器PN8395工作在原 边检测和调整模式,可省略系统的光耦和TL431, 支持CCM和DCM两种工作模式。PN8395拥有恒 压恒流控制环路, 可以实现高精度的恒压、恒流 输出,以满足大部分充电器和适配器需求。 PN8395内置高压启动电路和极低的芯片功耗使 得系统能够满足较高的待机功耗标准。

1. 高压启动控制

在启动阶段,采用高压启动技术,芯片启动前 1.0mA电流源为内部偏置电路供电并给外部VDD 电容充电,快速启动。当VDD电压达到V_{DDon},芯 片开始工作的同时高压启动电路关断; 只要VDD 电压不低于V_{DDoff}, 芯片维持正常工作。启动后, 偏置电路通过辅助源供电。

2. CC 工作模式

在CC工作状态, PN8395采样FB引脚的信号 (由辅助绕组信号通过电阻分压)和导通时间内 CS管脚上的中点电压V_{CS MID},根据辅助绕组信号 脉宽和CS管脚中点电压调整输出电流。

根据反激式开关电源的输出电流表达式,输 出电流可以表示为

$$I_O = \frac{N_P}{N_S} \frac{V_{CS_MID}}{R_{CS}} \frac{T_D}{T_P} \tag{1}$$

输出电流可以通过调整RCS电阻,实现恒流点 调整

$$R_{CS} = \frac{N_P}{N_S} \frac{1}{I_O} \frac{V_{REF_CC}}{K_{CC}} \tag{2}$$

其中V_{REF} CC为恒流输出的基准值, K_{CC}是芯片 内部设计值,为13.6。因此可以得到恒流输出。

3. CV 工作模式

在CV工作状态, PN8395使用脉冲信号采样 V_{EB}电压,并保持到下个采样点。将采样的电压和 V_{REF CV}基准比较,并放大误差。这个误差值代表 负载情况,通过控制开关信号,调节输出电压,使 得输出恒定。

输出电压Vo和V_{REF} CV的关系为

$$Vo = (V_{REF_CV} \times \frac{R1 + R2}{R2}) \times \frac{N_S}{N_{AUX}}$$
 (3)

其中, N_s 和 N_{AUX} 分别为次级绕组和辅助 绕组的圈数。

在重载条件,芯片工作在CCM模式,波形如 图1所示。

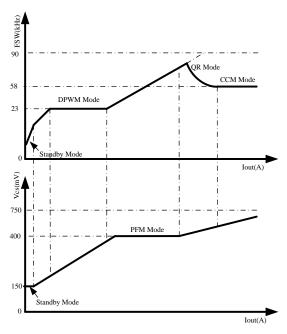


图1. 工作频率、V_{CS}和负载关系

4. 电流检测和前沿消隐

PN8395提供逐周期电流检测功能。芯片通过 CS引脚的电阻检测功率管电流, CC模式设置点和 最大输出功率都通过外部调整CS引脚上的电阻实 现。功率管开通瞬间会产生尖峰电压,内部前沿消 隐电路可防止误触发而不需要额外的RC滤波电 路。

5. 可编程线缆补偿功能

线缆补偿模块通过FB引脚输出一路补偿电 流,流向分压电阻,如图2所示,改变电压反馈值, 可以使输出线损压降得到补偿。当负载从满载减小 到空载时,线损压降也同样减小。PN8395通过设 置FB电阻的阻值可以调整线补偿的幅度。调整幅 度公式如下:

Chipown

$$\frac{V_{cable}}{V_O} = \frac{I_{cable} \times (R2 // R1)}{2.5V} \tag{4}$$

由于受到芯片采样位置和系统其他器件的影响,实际线补偿幅度小于理论计算值,但是趋势不 会改变。

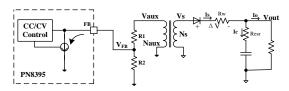


图2. 线补电流

6. 基准负温度补偿

如图2所示,FB采样电压为

$$V_{FB} = K(V_O + \Delta V), K = \frac{R2 \times N_{AUX}}{(R1 + R2) \times N_S}$$
 (5)

其中△V随着温度上升而变小,K为定值。

PN8395的 V_{REF_CV} 电压基准采用负温度补偿技术,常温下, V_{REF_CV} 电压基准为2.5V; 芯片温度上升时, V_{REF_CV} 电压基准值随着温度上升而变小,可以使 $\triangle V$ 随着温度上升而变小得到补偿,让输出电压 V_0 在全温度范围内恒定,提高了恒压输出精度。

7. 准谐振模式

PN8395包含一个独特的准谐振开关电路。 在CV工作状态下,这个电路检测每一个谐振周期的谷底位置,让芯片每个开关周期都在谷底导通。这个独特的电路可以减少系统的开关损耗。同时,准谐振模式可以让芯片的开关频率在不同的开关周期之间轻微的变化,提高EMI的裕量。

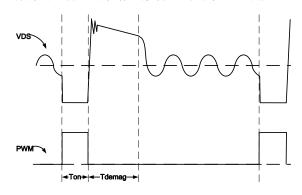


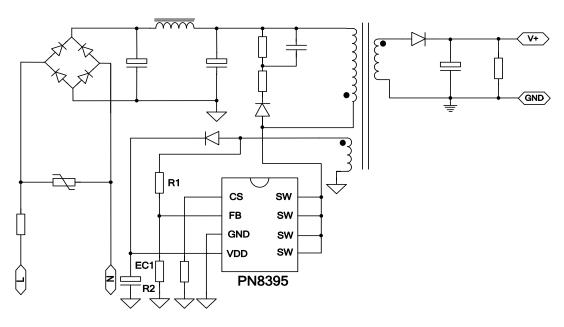
图3. 准谐振模式

8. 保护控制

PN8395含有丰富的保护功能,包括:逐周期过流保护、过压保护、过温保护、开环保护、输出短路保护、CS电阻开/短路保护、VDD欠压锁定保护功能,并且这些保护具有自恢复模式。



典型应用电路



外围参数选择参考

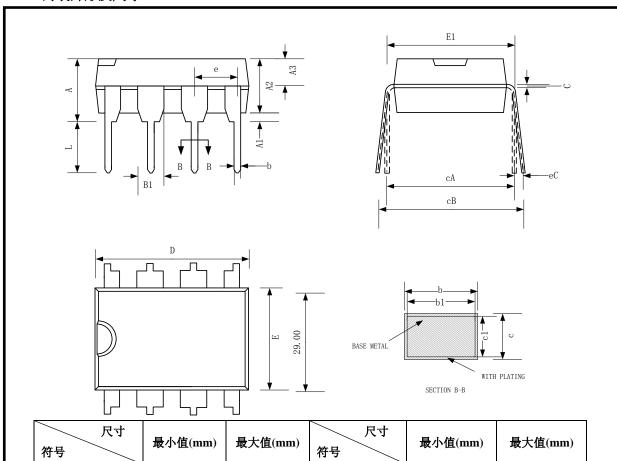
为了获得更佳的 PN8395 系统性能,请务必遵守以下规则:

1. VDD 电容 EC1 应放置在距离 VDD 引脚和 GND 引脚最近的地方。



<u>封装信息</u>

DIP8 封装外形及尺寸



尺寸 符号	最小值(mm)	最大值(mm)	尺寸 符号	最小值(mm)	最大值(mm)
A	3.60	4.00	c1	0.23	0.27
A1	0.51		D	9.05	9.45
A2	3.00	3.40	E1	6.15	6.55
A3	1.55	1.65	e	2.54BSC	
b	0.44	0.53	e A	7.62BSC	
b1	0.43	0.48	e B	7.62	9.30
B1	1.52	BSC	e C	0.00	0.84
c	0.24	0.32	L	3.00	

表层丝印	封装	
PN8395	DIDO	
YWWXXXXX	DIP8	

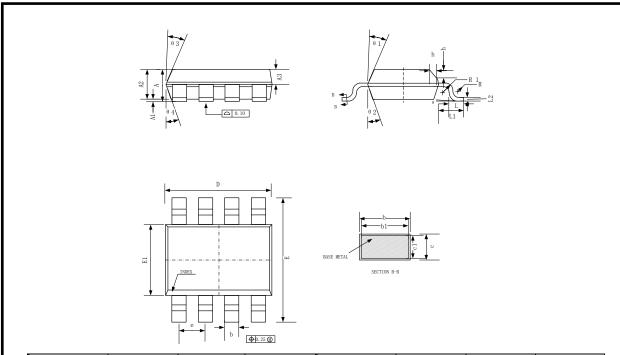
备注: Y: 年份代码; WW: 周代码; XXXXX: 内部代码

备注:

- 1. 此制图可以不经通知进行调整;
- 2. 器件本体尺寸不含模具飞边;



SOP8 封装外形及尺寸



尺寸 符号	最小(mm)	正常(mm)	最大(mm)	尺寸 符号	最小(mm)	正常(mm)	最大(mm)
A	1.35	1.55	1.75	L	0.45	0.60	0.80
A1	0.10	0.15	0.25	L1	1.04REF		
A2	1.25	1.40	1.65	L2		0.25BSC	
A3	0.50	0.60	0.70	R	0.07		
b	0.38	_	0.51	R1	0.07	_	_
b1	0.37	0.42	0.47	h	0.30	0.40	0.50
С	0.17		0.25	θ	0° — 8°		
c1	0.17	0.20	0.23	θ1	15° 17° 19		
D	4.80	4.90	5.00	θ2	11 °	13 °	15 °
Е	5.80	6.00	6.20	θ3	15°	17 °	19°
E1	3.80	3.90	4.00	θ4	11 °	13 °	15 °
e	1	1.270 (BSC)					

表层丝印	封装
PN8395	SOP8
YWWXXXX	SOF8

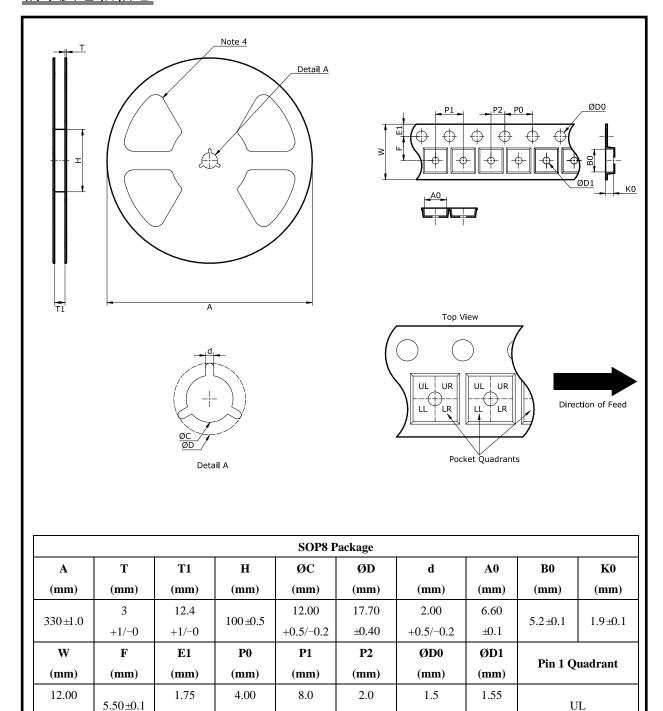
备注: Y: 年份代码; WW: 周代码; XXXXX: 内部代码

备注:

- 1. 此制图可以不经通知进行调整;
- 2. 器件本体尺寸不含模具飞边;



编带及卷轴信息



备注:

±0.1

- 1. 此制图可以不经通知进行调整;
- 2. 所有尺寸是毫米公制的标称值;
- 3. 此制图并非按严格比例,且仅供参考。客户可联系芯朋销售代表获得更多细节;

±0.10

±0.1

±0.10

4. 此处举例仅供参考。

±0.1

+0.1/-0

±0.05

PN8395



重要声明

无锡芯朋微电子股份有限公司保留更改规格的权利, 恕不另行通知。无锡芯朋微电子股份有限公司对任何将其产品用于特殊目的的行为不承担任何责任, 无锡芯朋微电子股份有限公司没有为用于特定目的产品提供使用和应用支持的义务。无锡芯朋微电子股份有限公司不会转让其专利许可以及任何其他的相关许可权利。